



Транзистор 2Т818А2

П 63 4120

ЭТИКЕТКА

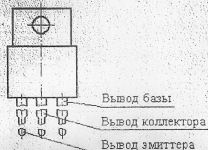
ЮФЗ.365.127 ЭТ

Кремниевые меза-планарные мощные высоковольтные р-р транзисторы 2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2 в пластмассовом корпусе КТ-28-2 ГОСТ 18472-88, предназначенные для юты в ключевых и линейных схемах аппаратуры специального назначения групп исполнения 1.1, 1.2, 1.5.1, 1.5.4, 1.1, 1.6.4, 1.7.1, 1.8.1, 2.1.1, 2.2.1 исполнения УХЛ по СТ РВ 20.39.304-98 с индивидуальной защитой или общей метализацией.

од даты изготовления транзисторов по ГОСТ 30668-2000.

Сертификат ЦОС "ВОЕНЭЛЕКТРОНЦЕРТ"
Филиал ФГБУ "46 ЦНИИ" Минобороны России
№ СВС.01.431.0491.13

Схема расположения выводов



1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные электрические параметры при $t_{корп} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		
		не менее	не более	
атический коэффициент передачи β , ($U_{КБ} = 5 \text{ В}$, $I_B = 5 \text{ А}$)	$h_{21Э}$	20		
ратный ток коллектора, мА $I_{КБ} = 100 \text{ В}$) 2Т818А2 $I_{КБ} = 80 \text{ В}$) 2Т818Б2 $I_{КБ} = 60 \text{ В}$) 2Т818В2	$I_{КБ0}$		1 1 1	
	обивное напряжение, $U_{КБ0 гр}$ $I_{КБ} = 100 \text{ мА}$, $200 \text{ мкс} \leq t_{и} \leq 300 \text{ мкс}$, ≥ 100 , $\Delta t_{изм} \geq 125 \text{ мкс}$, $U_{гр} = 95 \text{ В} \pm 10\%$, В		80	
		818А2	60	
818Б2		40		
818В2				
обивное напряжение коллектор-база, $U_{КБ0 проб}$ $I_{КБ} = 1 \text{ мА}$, В		100		
	818А2	80		
	818Б2	80		
	818В2	60		
обивное напряжение эмиттер-база, $U_{ЭБ0 проб}$ $I_{ЭБ} = 5 \text{ мА}$, В		5		
давление насыщения коллектор-иттер, ($I_{КБ} = 5 \text{ А}$, $I_{Э} = 0,5 \text{ А}$), В	$U_{КЭ макс}$		1	
давление насыщения база-эмиттер, ($I_{КБ} = 5 \text{ А}$, $I_{Э} = 0,5 \text{ А}$), В	$U_{ЭЭ макс}$		1,5	

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт.

транзисторов:
золото 0,0383 г
серебро 0,255 г

1.3 Содержание цветных металлов:

медь - 1,53 г в одном транзисторе.

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Минимальная наработка в режимах и условиях, допускаемых ТУ, 25000 ч, а в облегченном режиме при мощности 0,5, токах и напряжениях не более 0,7 максимально допустимых значений, $t_{корп} \leq 25^\circ\text{C}$ - 50000 ч.

2.2 Гамма-процентный ресурс при $\gamma = 95\%$ в режимах и условиях, допускаемых ТУ, 50000 ч, а в облегченном режиме - 80000 ч.

2.3 Минимальный срок сохраняемости транзисторов при их хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или во всех местах хранения транзисторов, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, 25 лет.

Пр: хранения транзисторов в упаковке изготовителя или вмонтированных в незащищенную аппаратуру, или находящихся в незащищенном комплекте ЗИП в неоттапливаемом хранилище, под навесом, а также на открытой площадке минимальный срок сохраняемости соответствует ГОСТ В 28146-89.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данных транзисторов требованиям А0.339.557 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в этикетке и технических условиях на транзисторы.

Гарантийный срок - 25 лет с даты изготовления, а в случае перепроверки транзисторов - с даты перепроверки. Гарантийная наработка:

25000 ч - в режимах и условиях, допускаемых ТУ;
50000 ч - в облегченном режиме.

Гарантийная наработка исчисляется в пределах гарантийного срока.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов 2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2 соответствуют техническим условиям А0.339.557 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № 9 от 6.04.15г.

ОТК
100
12

Место для штампа СКК

Место для штампа ВП

Место для штампа "Перепроверка произведена"

дата

Приняты по извещению № _____ от _____

дата

Место для штампа СКК

Место для штампа ВП

Цена договорная